



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L21464)

兹证明:

成都先进功率半导体股份有限公司实验室

(法人: 成都先进功率半导体股份有限公司)

四川省成都市高新区科新路 8 号科研大楼二楼, 611731

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2024-08-22

截止日期: 2030-08-21



中国合格评定国家认可委员会授权人 **陈朝华**

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

名称：成都先进功率半导体股份有限公司实验室

地址：四川省成都市高新区科新路8号科研大楼二楼

注册号：CNAS L21464

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024年08月22日 截止日期：2030年08月21日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	半导体电子元器件	1	高温反偏	半导体器件标准环境测试方法第1部分：方法1000至1999 MIL-STD-750-1:2015 方法1038.5，测试条件A	只测：高温反偏的电压： \leq 2000VDC；温度：25~175℃；工作空间： \leq 600mm*600mm*1200mm	2024-08-22
				半导体器件标准环境测试方法第1部分：方法1000至1999 MIL-STD-750-1:2015 方法1039.4，测试条件A	只测：高温反偏的电压： \leq 2000VDC，温度：25~175℃，工作空间： \leq	2024-08-22



No. CNAS L21464

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
					600mm*600mm*1200mm	
		2	低温存储寿命	低温存储寿命 JESD22-A119A:2021 3.1	只测：低温储存的温度：-40~-65℃；工作空间：≤550mm*500mm*600mm	2024-08-22
		3	高温栅偏	温度，偏置和工作寿命 高温栅偏 JESD22-A108G:2022 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.4, 5	只测：高温栅偏的电压≤2000VDC；温度：25~175℃；工作空间：≤600mm*600mm*600mm	2024-08-22
		4	高温存储寿命	高温存储寿命 JESD22-A103E.01:2021 4.1	只测：高温存储的温度：25~175℃，工作空间：600mm*600mm*600mm；	2024-08-22
		5	温度循环	温度循环 JESD22-A104F.01:2023 5.1~5.8	不测：5.7.2 互连斜坡速率。只测：温度循环的温度-65℃~150℃，工作空间：400*500*400mm	2024-08-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	无偏置高加速应力试验	加速抗湿-无偏置高加速应力试验 JESD22-A118B.01:2021 3, 4.1~4.3	只测：无偏置高加速应力试验的温度：130℃/110℃；相对湿度：85%RH；蒸汽压强：230kPa/122kPa；工作空间：≤φ420mm*657mm	2024-08-22
		7	高压锅试验	加速抗湿-无偏置高压锅 JESD22-A102E:2021 3, 4.1~4.3	只测：高压锅的温度：121℃；相对湿度：100%RH，蒸汽压强：205kPa；工作空间：≤φ420mm*657mm	2024-08-22
		8	高加速应力试验	高加速温度和湿度应力试验 JESD22-A110E.01:2021 3.1, 3.2.e).1), 4.1~4.4	只测：高加速温度和湿度应力试验的温度：130℃/110℃；相对湿度：85%RH；蒸汽压强：230kPa/122kPa；连续偏置，电压≤42VDC；工作空间：≤φ	2024-08-22



No. CNAS L21464

序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
					420mm*657mm	
		9	高温高湿反向偏置	稳态温度湿度偏置寿命试验 JESD22-A101D.01:2021 3.1, 3.2.e).1), 4.1~4.4	只测: 高温高湿反向偏置的温度:85℃, 相对湿度:85%RH, 连续偏置, 电压≤100VDC, 工作空间: ≤550mm*500mm*600mm	2024-08-22
		10	间歇工作寿命	半导体器件标准环境测试方法第1部分: 方法1000至1999 MIL-STD-750-1:2015 方法1037.3	只测: 间歇工作寿命器件的结温差≥100℃; 工作空间: ≤600mm*1230mm*700mm	2024-08-22
		11	温度湿度 (无偏置)	稳态温度湿度无偏置寿命试验 JESD22-A101D.01:2021 4.1~4.3	只测: 温度湿度 (无偏置) 的温度:85℃, 相对湿度:85%RH, 工作空间: ≤550mm*500mm*600mm	2024-08-22
		12	预处理	非密封表面安装器件在可靠性试验前的预处理 JESD22-A113I:2020 5.4~5.6	只测: 预处理的烘烤温度, 125℃, 工作空间:	2024-08-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		≤ 600mm*600mm*600mm; 2) 浸湿: 温度≤85℃, 相对湿度≤85%RH, 工作空间: ≤550mm*500mm*600mm; 3) 回流焊: 最高温度≥260℃	
		13	人体模型静电放电试验	人体模型（HBM）静电放电（ESD）测试 AEC-Q101-001 Rev-A :2005 3	人体模型静电放电试验的电压≤8000V	2024-08-22
		14	器件充电模型静电放电试验	器件充电模型（CDM）静电放电（ESD）测试 AEC-Q101-005 Rev-A:2019 2.3~2.5	器件充电模型静电放电的电压≤1000V	2024-08-22



No. CNAS L21464

在线扫码获取验证